



HY11P52B 低壓燒錄/查表/PFM

使用說明書

目 錄

1. 概述	4
2. BIE低壓燒錄功能	4
2.1 功能說明	4
2.2 ICE模擬說明	4
2.3 硬體電路	5
2.4 BIE燒錄動作說明	5
2.5 燒錄副程式說明	11
2.6 使用注意事項	14
3. 16BITS查表控制說明	15
3.1 ICE模擬說明	15
3.2 16BITS查表控制說明	15
3.3 使用注意事項	15
4. PFM控制迴路說明	16
4.1 ICE模擬說明	16
4.2 硬體電路	16
4.3 軟體設定	17
4.4 程式範例	17
4.5 電氣規格	17
5. ADC快速輸出設定	17
6. 附件程式	18
7. 修訂紀錄	18

注意：

- 1、本說明書中的內容，隨著產品的改進，有可能不經過預告而更改。請客戶及時到本公司網站下載更新 <http://www.hycontek.com>。
- 2、本規格書中的圖形、應用電路等，因第三方工業所有權引發的問題，本公司不承擔其責任。
- 3、本產品在單獨應用的情況下，本公司保證它的性能、典型應用和功能符合說明書中的條件。當使用在客戶的產品或設備中，以上條件我們不作保證，建議客戶做充分的評估和測試。
- 4、請注意輸入電壓、輸出電壓、負載電流的使用條件，使 IC 內的功耗不超過封裝的容許功耗。對於客戶在超出說明書中規定額定值使用產品，即使是瞬間的使用，由此所造成的損失，本公司不承擔任何責任。
- 5、本產品雖內置防靜電保護電路，但請不要施加超過保護電路性能的過大靜電。
- 6、本規格書中的產品，未經書面許可，不可使用在要求高可靠性的電路中。例如健康醫療器械、防災器械、車輛器械、車載器械及航空器械等對人體產生影響的器械或裝置，不得作為其部件使用。
- 7、本公司一直致力於提高產品的品質和可靠度，但所有的半導體產品都有一定的失效概率，這些失效概率可能會導致一些人身事故、火災事故等。當設計產品時，請充分留意冗餘設計並採用安全指標，這樣可以避免事故的發生。
- 8、本規格書中內容，未經本公司許可，嚴禁用於其他目的之轉載或複製。

1. 概述

HY11P52B 為 HY11P 系列增加之一新型號，亦可被定位為 HY11P52 之升級產品。產品優勢如下：

- 優化內建 EPROM 刻錄技術，使 $VDD \geq 2.75V$ 即可執行低壓刻錄技術，生產校正時無須再額外接電源；
- LCD 驅動功能模組消耗電流降低至 8uA；
- 當要使用 HY11P52B EPROM 刻錄功能，若要轉換來自 HY11P52 程序時，則原本 HY11P52 EPROM 刻錄程序中，需更新 EPROM 刻錄技術函數名稱後 (WR1WORDBIEDATA → LVWRBIE)，並將原始程式碼重新在 HY11P52B 環境下組譯後才可使用；

相對於 HY11P32 產品，其優勢如下：

- ADC 輸出速率可從原來的 1Ksps 提高至 2Ksps，適合其他需要稍快 ADC 速度且解析度 12-bit 的應用；
- 增強 VDDA 快速啟動功能，只需要 1m sec 時間內 VDDA 電源即可穩定；
- 自動開機秤重應用平均功耗可再省一半 (Output rate=2ksps)；
- 透過 BIE 16bits 指令讀取方式，可讀回程式記憶體中 (OTP ROM CODE) 建表資料，在需要大量使用查表功能的程式需求時，可節省程式空間；
- 內建 LED 背光定電流控制回路，採自動回授設計最大可提供 15mA 電流以驅動白光或藍光 LED (電源由 I/O 提供，可提供 10mA 電流；電源由 VDD 提供，則可提供 15mA 電流)；
- 若在不使用 HY11P52B 新增功能下，原本 HY11P32 與 HY11P52 開發之原始碼與 PCB Layout，只需將原始程式碼重新在 HY11P52B 環境下重新組譯即可使用，原硬體電路及 PCB 均不需任何工程變更即可使用；

2. BIE 低壓燒錄功能

2.1 功能說明

低壓燒錄控制技術提供使用者可以不需外接燒錄電壓源下，仍可進行 BIE 區塊資料燒錄動作。其 Built-In EPROM 架構仍相同於既有架構，資料可參考 UG-HY11S14 章節 22 內容說明。http://www.hycontek.com/attachments/MSP/UG-HY11S14_TC.pdf

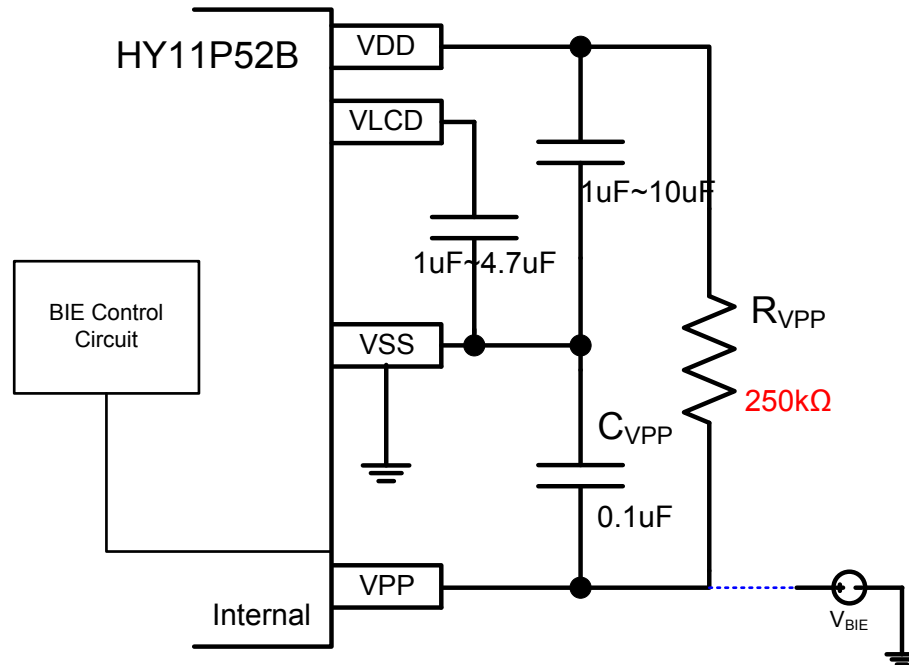
2.2 ICE 模擬說明

現有 ICE 尚無支援 BIE 低壓燒錄控制技術，客戶在使用 ICE 模擬時，仍需接外部 VBIE 電源 (6V) 才能順利進行 BIE 燒錄動作，執行動作同樣為呼叫完整燒錄副程式 (LVWRBIE) 或簡易版燒錄副程式 (LVWRBIE_SIMPLE) 進行燒錄。

2.3 硬體電路

使用 BIE 功能時必須外接 R_{VPP} 與 C_{VPP} 外部零件。

建議 C_{VPP} 電容值為 $0.1\mu\text{F}$ ， R_{VPP} 電阻值為 $250\text{k}\Omega$;



BIE Typical Application

2.4 BIE燒錄動作說明

◆ BIE 燒錄設定模式選擇

當使用外部 V_{BIE} 電源(6V)燒錄 BIE 區塊時，可以透過指令一次燒錄一個位元組(word)資料於 BIE 區塊內；

當啟動**完整版本低壓燒錄控制電路**時，則不需外接 V_{BIE} 電源仍可燒錄 BIE 區塊，但須呼叫於 WR3.OBJ 的完整版本燒錄副程式(LVWRBIE)才能進行燒錄；每次呼叫燒錄副程式進行燒錄動作，僅能燒錄一個位元組(word)資料，所**花費時間約 150msec**。而該燒錄函數僅包含 BIE 區塊資料燒錄，並未執行資料檢查，使用者需自行檢查燒錄資料正確性。

為了提供客戶更多程序空間可以使用，另外提供客戶簡易版本燒錄副程序，該使用方式同樣為，當啟動**簡易版本低壓燒錄控制電路**時，則不需外接 V_{BIE} 電源仍可燒錄 BIE 區塊，但須呼叫於 WR4.OBJ 的簡易版本燒錄副程式(LVWRBIE_SIMPLE)才能進行燒錄；每次呼叫燒錄副程式進行燒錄動作，僅能燒錄一個位元組(word)資料，所**花費時間約 150msec**。而該燒錄函數僅包含 BIE 區塊資料燒錄，並未執行資料檢查，使用者需自行檢查燒錄資料正確性。

◆ BIE 軟體設定說明(使用外部 V_{BIE} 電源(6V)燒錄 BIE 區塊)

使用外部 V_{BIE} 電源(6V)燒錄 BIE 區塊，請參考 UG-HY11S14，章節 22.1, BIE 使用說明內容，下面列出 Write EPROM and Read EPROM 程序：

WRITE EPROM:

```
BCF  ADCCN1,ENADC,0      ;寫入 EPROM 前先關閉 ADC 功能
VPPCHK:
BTSS  BIECTRL,VPP_HIGH,0 ;檢查 VPP 電壓是否存在，存在才繼續燒錄動作
JMP   VPPCHK
MVL   10000000B
MVF   BIEPTRH, 1, 0      ;BIEPTRH [7]=1b 啟動 BIE 區塊燒寫功能
MVL   00000000B
MVF   BIEPTL, 1, 0       ;定義 EPROM 燒錄位置為 00H
MVL   12H                ;定義寫入資料[BIEDH, BIEDL]=[12H,34H]
MVF   BIEDH, 1, 0
MVL   34H
MVF   BIEDL, 1, 0
BSF   BIECTRL, BIEWR, 0  ;若 BIECTRL[VPP_HIGH]=0 或
                           ;BIEPTL > 3FH,
                           ;則此指令無效(BIEPTRH=0x80)
                           ;若 BIECTRL[VPP_HIGH]=1 且 BIEPTL ≤ 3FH,
                           ;則此指令有效(BIEPTRH=0x80)
                           ;EPROM 寫入完成後，BIECTRL[BIEWR]自動清除為 0
                           ;BIEPTL 自動遞增 1，最多至 3FH

WAITWRBIE:
BTSZ  BIECTRL, BIEWR, 0  ;等待判斷 EPROM 寫入完成後 ;BIECTRL[BIEWR]自動清除為 0
JMP   WAITWRBIE
;BSF  ADCCN1,ENADC,0     ;視使用者需求開啓 ADC 功能
```

注意事項:寫入 EPROM 前，先關閉 ADC 功能(ADCCN1[ENADC]=0b)，則可增強 ADC 抗干擾能力。等待寫入 EPROM 完成後，再開啓 ADC 功能進行訊號測量。

READ EPROM:

```
BCF ADCCN1,ENADC,0 ;讀取 EPROM 前先關閉 ADC 功能
MVL 10000000B
MVF BIEPTRH, 1, 0 ;BIEPTRH [7]=1b 啓動 BIE 區塊燒寫功能
MVL 00000000B
MVF BIEPTL, 1, 0 ;定義 EPROM 讀取位置為 00H
BSF BIECTRL, BIERD, 0 ;讀取 EPROM，並將資料存放於暫存器 BIEDH, BIEDL
;EPROM 讀取完成後，BIECTRL[BIERD]自動清除為 0
;BIEPTL(BIE_ADDR)自動遞增 1，最多至 3FH
```

WAITRDBIE:

```
BTSZ BIECTRL, BIERD, 0 ;等待判斷 EPROM 讀取完成後，BIECTRL[BIERD]自動清除為 0
JMP WAITRDBIE
MVF BIEDL, 0, 0
MVF BUF0, 1, 0 ;將 BIEDL 數據搬移至 BUF0
MVF BIEDH, 0, 0
MVF BUF1, 1, 0 ;將 BIEDH 數據搬移至 BUF1
;BSF ADCCN1,ENADC,0 ;視使用者需求開啓 ADC 功能
```

注意事項:讀取 EPROM 前，先關閉 ADC 功能(ADCCN1[ENADC]=0b)，則可增強 ADC 抗干擾能力。等待讀取 EPROM 完成後，再開啓 ADC 功能進行訊號測量。

◆ **BIE 軟體設定說明(使用 WR3.OBJ 完整版本低壓燒錄控制電路燒錄 BIE 區塊)**

當使用 WR3.OBJ 完整版低壓燒錄控制電路燒錄 BIE 區塊時，則須依下列動作進行：

WRITE EPROM:

```

MVL 10000000B
MVF BIEPTRH, 1, 0 ;BIEPTRH [7]=1b 啓動 BIE 區塊燒寫功能
MVL 00000000B
MVF BIEPTL, 1, 0 ;定義 EPROM 燒錄位置為 00H
MVL 12H ;定義寫入資料[BIEDH, BIEDL]=[12H,34H]
MVF BIEDH, 1, 0
MVL 34H
MVF BIEDL, 1, 0
;..... ;使用者需自行備份受影響的寄存器
CALL LVWRBIE ;該函數在執行期間暫時關閉 LCD 顯示,待完成後恢復顯示
;使用者須確保 VDD ≥ 2.75V，才能校正成功
;BIEPTL > 3FH, 則此指令無效 (BIEPTRH=0x80)
;BIEPTL ≤ 3FH, 此指令才有效 (BIEPTRH=0x80)
;EPROM 寫入完成後，BIEPTL 自動遞增 1，最多至 3FH
;Return WREG=0, 該位元組資料燒錄動作完成
;Return WREG=1;代表 VDD 電壓不足或低壓控制電路失效
;該副程式只針對寫入判斷，並未檢查燒錄值正確性
;..... ;使用者自行還原受影響的寄存器
;BSF ADCCN1,ENADC,0 ;視使用者需求開啓 ADC 功能, LVD 功能等
BSF INTE1,GIE ;燒錄副程式已經把中斷源 GIE 關掉
;完成燒錄後，使用者請自行把 GIE 打開
TFSZ WREG,0 ;WREG 判斷程式，判斷是否燒錄完成
JMP FAIL ;WREG=0b, WRITE BIE FAIL
;... ;其他執行程序
FAIL:
IDLE
NOP
INCLUDE WR3.obj ;WR3.obj 檔案須放置在程式最後面
END
    
```


◆ **BIE 軟體設定說明(使用 WR4.OBJ 簡易版本低壓燒錄控制電路燒錄 BIE 區塊)**

當使用 WR4.OBJ 簡易版低壓燒錄控制電路燒錄 BIE 區塊時，則須依下列動作進行：

WRITE EPROM:

```

BCF  ADCCN1,ENADC,0 ;寫入 EPROM 前先關閉 ADC 功能(使用者自行設定)
MVL  10000000B
MVF  BIEPTRH, 1, 0 ;BIEPTRH [7]=1b 啓動 BIE 區塊燒寫功能
MVL  00000000B
MVF  BIEPTL, 1, 0 ;定義 EPROM 燒錄位置為 00H
MVL  12H ;定義寫入資料[BIEDH, BIEDL]=[12H,34H]
MVF  BIEDH, 1, 0
MVL  34H
MVF  BIEDL, 1, 0
MVF  FSR0L,0,0
MVF  FSR_BUF,1,0 ;自行備份受影響寄存器
BCF  MCKCN2,1,0 ;設定 CPUCLK=00b=2Mhz(使用者自行設定)
BCF  MCKCN2,0,0
CALL LVWRBIE_SIMPLE ;該函數在執行期間暫時關閉 LCD 顯示,待完成後恢復顯示
;使用者須確保 VDD ≥ 2.75V，才能校正成功
;BIEPTL > 3FH, 則此指令無效 (BIEPTRH=0x80)
;BIEPTL ≤ 3FH, 此指令才有效 (BIEPTRH=0x80)
;EPROM 寫入完成後，BIEPTL 自動遞增 1，最多至 3FH
;Return WREG=0, 該位元組資料燒錄動作完成
;Return WREG=1;代表 VDD 電壓不足或低壓控制電路失效
;該副程式只針對寫入判斷，並未檢查燒錄值正確性
;..... ;使用者自行還原受影響的寄存器
BCF  MCKCN2,1,0 ;還原 CPUCLK=01b=1Mhz(使用者自行還原)
BSF  MCKCN2,0,0
MVL  11011100B ;還原 LCDCN1 控制寄存器資料
MVF  LCDCN1,1,0
;BSF  ADCCN1,ENADC,0 ;視使用者需求開啓 ADC 功能, LVD 功能等
BSF  INTE1,GIE ;燒錄副程式已經把中斷源 GIE 關掉
;完成燒錄後，使用者請自行把 GIE 打開
TFSZ WREG,0 ;WREG 判斷程式，判斷是否燒錄完成
JMP  FAIL ;WREG=0b, WRITE BIE FAIL
;... ;其他執行情序
FAIL:
IDLE
NOP

```

```
INCLUDE WR4.obj      ;WR4.obj 檔案須放置在程式最後面  
END
```

註: **WR4.OBJ** 簡易版本低壓燒錄控制電路燒錄 **BIE** 區塊函式庫經過簡化處理, 其內置控制寄存器初始化動作與資料還原動作已經移除, 需由使用者自行設定, 若無設定將會造成燒錄錯誤及其他異常發生, 請使用者參考以上範例程序設定說明。如以下動作需由使用者自行設定: **ADC** 關閉及 **CPUCLK** 切換成 **2Mhz** 及還原 **LCDCN1** 控制寄存器設定等。

READ EPROM:

```
BCF  ADCCN1,ENADC,0 ;讀取 EPROM 前先關閉 ADC 功能
MVL  10000000B
MVF  BIEPTRH, 1, 0 ;BIEPTRH [7]=1b 啟動 BIE 區塊讀取功能
MVL  00000000B
MVF  BIEPTL, 1, 0 ;定義 EPROM 讀取位置為 00H
BSF  BIECTRL, BIERD, 0 ;下指令讀取 EPROM，並將資料存放於暫存器 BIEDH/L
;EPROM 讀取完成後，BIECTRL[BIERD]自動清除為 0
;BIEPTL(BIE_ADDR)自動遞增 1，最多至 3FH
```

WAITRDBIE:

```
BTSZ BIECTRL, BIERD, 0 ;等待判斷 EPROM 讀取完成後,BIECTRL[BIERD]是否自動清除為 0
JMP  WAITRDBIE
MVF  BIEDL, 0, 0
MVF  BUF0, 1, 0 ;將 BIEDL 數據搬移至 BUF0
MVF  BIEDH, 0, 0
MVF  BUF1, 1, 0 ;將 BIEDH 數據搬移至 BUF1
;BSF  ADCCN1,ENADC,0 ;視使用者需求開啓 ADC 功能
```

2.5 燒錄副程式說明

◆ 受影響寄存器:

Special Register: WREG, LVDCN, FSR0L, INDF0, INTE1[GIE]. ADCCN1[ENADC], LCDCN2[LCDBL]

Data Register: 0F0h~0F5h.

◆ 保留堆疊層:

至少保留 3 層堆疊層才能正常呼叫該副程式。

◆ Option Function:

進入副程序時，GIE 中斷源將被關閉，當時副程序後，使用者需自行啟動 GIE 功能；副程式中自動啟動晶片內部 LVD 低電壓偵測線路，離開副程式後將會自動關閉 LVD 功能，使用者需自行設定使用。副程序中也將暫時關閉 LCD 顯示功能(LCDCN2[LCDBL]=1b)，待執行副程序之後才會再啟動開啓 LCD 顯示(LCDCN2[LCDBL]=0b)

註：使用者需注意，使用該燒錄副程式，須確定 $VDD \geq 2.75V$ ，以確保燒錄成功!

◆ Code Size: 83 行指令空間; (完整版本低壓燒錄控制電路函數 WR3.OBJ)

◆ Code Size: 71 行指令空間; (簡易版本低壓燒錄控制電路函數 WR4.OBJ)

◆ Function return value:

Return WREG=1, 代表 VDD 電壓不足，或是低壓控制電路失效。

Return WREG=0, 代表該位元組(word)資料燒錄於 BIE 區塊動作完成。

但僅燒錄完成，並未檢查燒錄值正確性，使用者需自行檢查。

◆ WR3.OBJ 函數內容說明:

WR3 函數為完整版本低壓燒錄控制電路函數，該函數已經包含關閉 ADC 及 CPUCLK 頻率設定達晶片最佳化功能，使用者可以將原本主程序中這兩項動作移除，可達到減少程序空間。WR3 函數已經過優化處理，不允許使用者修改內容，以避免發生 BIE 燒錄錯誤情形發生。WR3 內建程序行為說明如下：

LVWRBIE:

```

BCF    INTE1,GIE,A           ;disable GIE
BCF    ADCCN1,ENADC,A        ;disable ADC
MVL    00000111b             ;enable LVD
MVF    LVDCN,F,A
MVF    MCKCN2,W,A
MVF    MCKCN2BUF,F,A
CLRF   MCKCN2,A              ;set CPUCLK=2Mhz
BSF    LCDCN2,LCDBL,A        ;disable LCD display
BTSZ   LVDCN,LVD,A
JMP    FAILLOOP              ;VDD 電壓不足則強制退出 BIE, 不進行燒錄, WREG=1
BTSS   BIECTRL,VPP_HIGH,A   ;CHECK VPP Flag
JMP    FAILLOOP              ;VPP Flag=0, 強制退出 BIE, 不進行燒錄, WREG=1
.....                          ;執行 BIE 資料燒錄動作
.....
.....                          ;當執行完成 BIE 燒錄動作後, 開始還原相關設定
CLRF   LVDCN,A               ;DISABLE LVD FINCTION
MVF    MCKCN2BUF,W,A         ;還原 MCKCN2 設定
MVF    MCKCN2,F,A
BCF    LCDCN2,LCDBL,A        ;ENABLE LCD display
RETL   0                      ;BIE 燒錄完成, WREG=0
FAILLOOP:
MVF    MCKCN2BUF,W,A         ; 還原 MCKCN2 設定
MVF    MCKCN2,F,A
CLRF   LVDCN,A               ;DISABLE LVD FINCTION
BCF    LCDCN2,LCDBL,A        ;ENABLE LCD display
RETL   1                      ;VDD 電壓不足, 強制退出 BIE, 不進行燒錄, WREG=1
;or VPP Flag=0, 強制退出 BIE, 不進行燒錄, WREG=1
    
```

◆ WR4.OBJ 函數內容說明:

WR4 函數為簡易版本低壓燒錄控制電路函數，該函數已經移除**內置控制寄存器初始化動作與資料還原動作**，使用者需在呼叫使用該函數前先自行設定，若無設定將會造成燒錄錯誤、燒錄時間變長及其他異常發生。而 WR4 函數已經過優化處理，不允許使用者修改內容，以避免發生 BIE 燒錄錯誤情形與其他異常發生。WR4 內建程序行為說明如下：

LVWRBIE_SIMPLE:

```
BCF    INTE1,GIE,A           ;disable GIE
MVL    00000111b            ;enable LVD
MVF    LVDCN,F,A
BSF    LCDCN2,LCDBL,A       ;disable LCD display
BTSZ   LVDCN,LVD,A
JMP    FAILLOOP             ;VDD 電壓不足則強制退出 BIE, 不進行燒錄, WREG=1
BTSS   BIECTRL,VPP_HIGH,A  ;CHECK VPP Flag
JMP    FAILLOOP             ;VPP Flag=0, 強制退出 BIE, 不進行燒錄, WREG=1
.....                          ;執行 BIE 資料燒錄動作
.....
.....                          ;當執行完成 BIE 燒錄動作後, 開始還原相關設定
CLRF   LVDCN,A              ;DISABLE LVD FINCTION
CLRF   LCDCN1,1,0           ;DISABLE LCD FUNCTION
BCF    LCDCN2,LCDBL,A       ;ENABLE LCD display
RETL   0                     ;BIE 燒錄完成, WREG=0
FAILLOOP:
CLRF   LVDCN,A              ;DISABLE LVD FINCTION
CLRF   LCDCN1,1,0           ;DISABLE LCD FUNCTION
BCF    LCDCN2,LCDBL,A       ;ENABLE LCD display
RETL   1                     ;VDD 電壓不足, 強制退出 BIE, 不進行燒錄, WREG=1
                                         ;or VPP Flag=0, 強制退出 BIE, 不進行燒錄, WREG=1
```

2.6 使用注意事項

HY11P52B 晶片使用低壓燒錄控制電路功能，僅適用於溫度範圍 $0^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 之間， $2.75\text{V}\leq\text{VDD}\leq 3.60\text{V}$ 條件。若晶片使用外接 V_{BIE} 電源(6V)燒錄 BIE 區塊時，則只能透過單一指令燒錄資料(BSF BIECTRL,BIEWR,0)，並且於該模式下不得使用完整版燒錄副程式(LVWRBIE)或簡易版燒錄副程式(LVWRBIE_SIMPLE)進行燒錄動作，避免資料燒錄時發生錯誤。

啟動低壓燒錄控制電路後，必須設定電壓源 $\text{VDD}\geq 2.75\text{V}$ ，才能正常燒錄。

啟動低壓燒錄控制電路時，GIE 中斷控制源被強制關閉，LVD 功能將被關閉。

建議所有校正值均於量測完成後，再啟動低壓燒錄控制電路進行 BIE 區塊燒錄。

當外接 V_{BIE} 電源(6V)燒錄 BIE 區塊前，先關閉 ADC 功能則可使抗干擾能力增強。

使用者需留意呼叫燒錄副程式後受影響的暫存器。

開發工具(模擬器)只支援 HY11S14-DK02，無支持 HY11S14-DK01;

開發工具(模擬器)目前無法模擬低壓燒錄和 16bits 查表功能；

當使用者利用開發工具(模擬器)模擬 HY11P52B 低壓燒錄功能時，則需外接 V_{BIE} 電源(6V)於模擬器上，才能使程式正常執行。

3. 16BITS查表控制說明

HY11P52B 為 H08B 指令集，但 HY08B 指令並不支援 16bits 查表指令。而 HY11P52B 則在 HY08B 基礎上新增了 16BITS 查表指令功能；

ROM Code(程式記憶體)查表功能需設置 BIEPTRH [7]=0b，來達到啟動 16Bits 查表功能。其 BIEPTRH[2:0] / BIEPTL[7:0]決定 11bits ROM Code 讀取地址，BIEPTRH[2:0]為 Bit11 ~ Bit9 地址，BIEPTL[7:0]為 Bit7 ~ Bit0 地址。查表後數據放置於 BIEDH/BIEDL 暫存器中。

3.1 ICE模擬說明

現有 ICE 尚無支援 HY08B 指令 16bits 查表指令，客戶在 ICE 仿真使用時，請依以下軟體設定方法執行，並在實際產品上進行驗證。

3.2 16BITS查表控制說明

◆ 16Bits 查表軟體設定說明

16BITS_READ:

```

MVL    HIGH Table
MVF    TBLPTRH,F,ACCE
BCF    TBLPTRH,7
MVL    LOW Table
MVF    TBLPTL,F,ACCE
BSF    TBLCTRL, TBLRD, 0
MVF    TBLDL, 0, 0
MVF    BUF0, 1, 0           ;將 BIEDL 數據搬移至 BUF0
MVF    TBLDH, 0, 0
MVF    BUF1, 1, 0
    
```

Table:

```
DB     05AH, 0A5H
```

3.3 使用注意事項

當使用 ROM Code 查表時，需設定 BIEPTRH [7]=0b 來啟動功能；而 BIEPTRH [6:3] 則需強制設定成 0000b。

若要切換回 BIE 燒錄與讀取時，需設定 BIEPTRH [7]=1b 來啟動功能；而 BIEPTRH [6:0]則需強制設定成 0000000b，BIEPTL [7:6]則需強制設定成 00b。

ROM Code 只允許透過指令達查表功能，其他寫入動作被視為無效(BSF BIECTRL, BIEWR, 0)。

ROM Code 查表與 BIE 燒錄與讀取功能兩者不能同時使用。

開發工具(模擬器)只支援 HY11S14-DK02 硬體，原 HY11S14-DK01 硬體則不再支援。

開發工具(模擬器)仍無法仿真 16Bits 查表說明。

4. PFM控制迴路說明

在驅動高電壓 LED 背光時，3V 電池供電很容易在電池電壓下降後導致驅動失效，HY11P52B 採用簡單的 PFM 控制迴路，以升高驅動電壓，來達到驅動 LED 背光的電壓；HY11P52B 採用回授輸入判斷，控制 PFM 輸出頻率，已達到輸出穩定電壓的目的；PFM 模組與 LVD 模組共用迴路，應用開發上請自行切換使用，同一時間內只能使用單一模組功能。

4.1 ICE模擬說明

現有 ICE 尚無支援 PFM 控制迴路電路，客戶在 ICE 仿真使用時，請依以下軟體設定方法執行，並在實際產品上進行驗證。

4.2 硬體電路

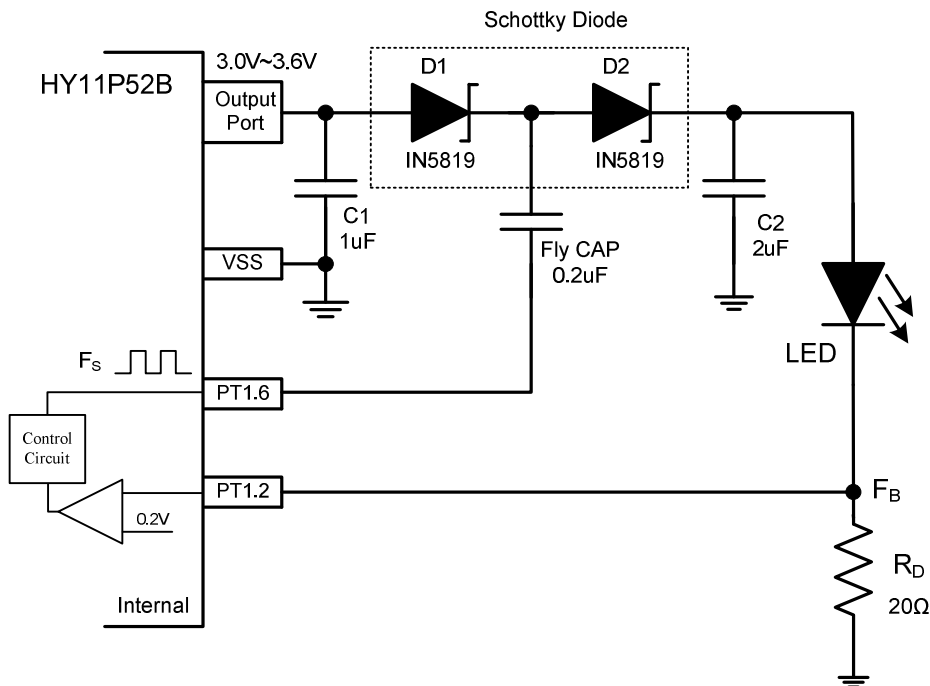
電源端穩壓電容 C1, 1uF.

Schottky Diode IN5819, D1,D2.

Fly Cap, 0.2uF

輸出端穩壓電容 C2, 2uF.

Detection Resistance, R_D , 20 Ω



PFM Typical Application for LED Applications

4.3 軟體設定

PFM 控制迴路啟動設定: PWMRCN[ENLEDP] =1.

使用該控制迴路，則 PT1.2 需設定成輸入引腳，PT1.6 需設定成輸出引腳。

4.4 程式範例

CLRF PT1PU,A

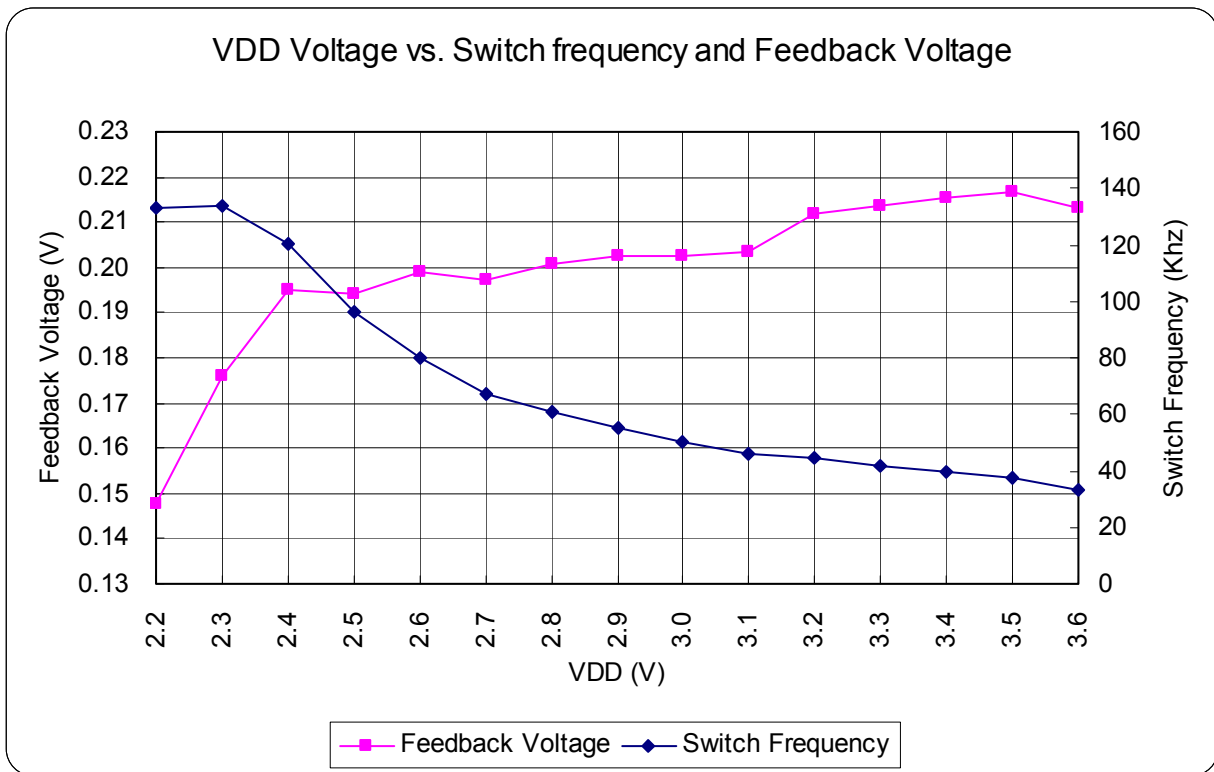
MVL 01000000b ; PT1.2 需設定成輸入引腳，PT1.6 需設定成輸出引腳

MVF TRISC1,1,0

BSF PWMRCN,ENLEDP,0 ; 啟動 PFM 控制回路

4.5 電氣規格

以下列出典型的 VDD 與 Switch frequency (F_S)和 Feedback Voltage(F_B)等關係。



VDD Voltage vs. Switch frequency and Feedback Voltage Chart

5. ADC快速輸出設定

HY11P52B $\Sigma\Delta$ ADC 提供較快速輸出功能，可透過設置 OSR[3:0]=1010b，來達到設定 OSR=128，等效 ADC 輸出率約為 2Ksps 的快速輸出設置。

軟體設置方法如下：

MVL 01000010B

MVF ADCCN3,1,0 ; 設定 HY11P52B $\Sigma\Delta$ ADC 輸出頻率為 2Ksps

6. 附件程式



WR3.obj

WR3.OBJ :



WR4.obj

WR4.OBJ :

相關 OBJ 檔案可以在 DemoCode 安裝目錄下取得：

C:\Program Files\HyIDE\HyconIDE\DemoCode\HY11P52B\WR3.OBJ

C:\Program Files\HyIDE\HyconIDE\DemoCode\HY11P52B\WR4.OBJ

7. 修訂紀錄

以下描述本檔差異較大的地方，而標點符號與字形的改變不在此描述範圍。

版本	頁次	變更摘要
V01	ALL	初版發行